

# **ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ КРИСТАЛЛОВ ТГС, ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ ОБЛУЧЕННЫХ ЗАТРАВОК**

*Рогазинская О. В., Миловидова С. Д., Сидоркин А. С., Плаксицкий А. Б.*

В настоящей работе исследовалась эмиссия электронов из сегнетоэлектрических кристаллов ТГС, выращенных из облученных рентгеновскими лучами и  $\alpha$ -частицами затравок.

Установлено, что независимо от источников облучения затравки (рентгеновские лучи или  $\alpha$ -частицы) значения тока эмиссии всегда больше с «отрицательной» поверхности. Величина тока эмиссии электронов тем больше, чем больше униполярность образцов. Показано, что униполярность образцов выше у кристалла ТГС, выращенного из затравки, облученной  $\alpha$ -частицами, что вероятно связано с большей величиной внутреннего смещающего поля сформированного под действием  $\alpha$ -частиц по сравнению с рентгеновскими лучами.